

性能特点

- 频率范围：100~700MHz
- 高效率，大动态：55mA输出21dBm(典型值)
- 采用有源偏置设计提供温度补偿
- 良好的50Ω阻抗匹配，易于级联使用
- 微波薄膜电路结构，电性能稳定可靠
- 采用标准全密封金属管壳封装
- 满足军温工作条件：-55℃~+85℃

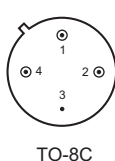
电性能表 (50Ω测试系统, $V_{CC}=+15V$, $T_A=-55^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

性能参数	符号	单位	规范值	典型值
频率范围	$f_L \sim f_H$	MHz	100~700	—
小信号功率增益	G_p	dB	$\geq 21.0 \Delta$	22.0
增益平坦度	ΔG_p	dB	$\leq 1.0 \Delta$	0.6
噪声系数	F_n	dB	$\leq 4.5 \Delta$	3.8
输入驻波比	VSWRi	—	$\leq 2.0:1 \Delta$	1.5:1
输出驻波比	VSWRo	—	$\leq 2.0:1 \Delta$	1.5:1
线性输出功率	P_{-1}	dBm	$\geq 20.0 * \Delta$	21.0
工作电流	I_{CC}	mA	—	55

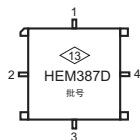
注：1) “*” $f=200MHz$ ；规范值中带“ Δ ”的参数为常温参数。
2) $V_{CC}=12V$ 下 G_p 下降0.2dB, P_{-1} 下降2.5dB, 电流为45mA(Typ)。
如产品使用于12V情况下, 请订货时标明, 以便测试提供。

极限参数

最高电源电压：+18VDC
最大输入功率：+7dBm
最高储存温度：+125℃



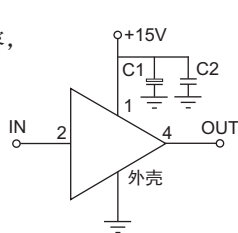
TO-8C



SMO-8C

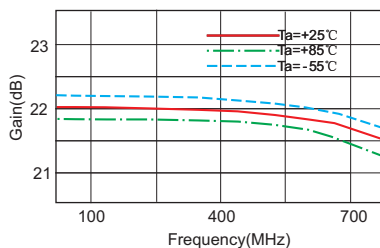
使用说明

1. 电路按右图连接，内部集成有耦合电容， $C_1=3.3 \sim 22 \mu F$ ； $C_2=3300 \sim 6800 pF$ ；
2. 可与美国W-J公司A89替换使用；
3. 可提供盒体结构(SMA输出)SMA-1封装类型的产品；
4. 外形尺寸和安装使用方法见本册附后的《封装外形尺寸及安装使用说明》页。

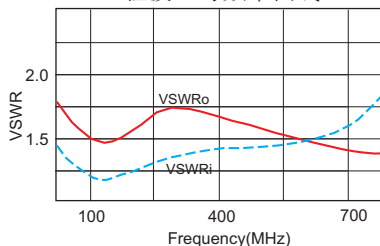


典型曲线

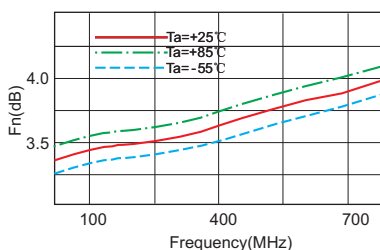
增益与频率曲线



驻波比与频率曲线



噪声与频率曲线



输出功率和OIP3与频率曲线

